Перв. примен.		Поз. обозн.	Наил	менование	Кол.	Примечание	
	ΑΠΕΦ		Vous	day, a many .	-		
		C1		Ренсаторы	+-	ЧИП-0805; 50 B; NP0;	
		C2		/CxxxKAT2A	1	315пФ для подстройки ЧИП-0805; 50 B; X7R;	
		C3C5		/C103KAT2A	1	10нФ; 10 %; AVX ЧИП-0805; 50 B; X5R;	
		C8, C9	08057	C104KAT2A	8	0,1 мкФ; 10 %; AVX	
F	H	C13C15			-		
			00051		_	ЧИП-0805; 10 B; X5R;	
Справ. №	S	C6		C104KAT2A	1	4,7 мκΦ; 10 %; AVX	
		C7		C101KAT2A	1	ЧИП-0805; 50 В; NP0; 100 nФ; 10 %; AVX	
	81401.xls	C10, C16	0805Y	C222KAT2A	3	ЧИП-0805; 50 B; X7R; 2,2 нФ; 10 %; AVX	
Cult	814						
П		C11	0805Y	C474KAT2A	2	ЧИП-0805; 50 В; NPO; 0,47мкФ; 10 %; AVX	
П		C12	0805Y	C561KAT2A	2	ЧИП-0805; 50 В; NPO; 560nФ; 10 %; AVX	
		C18	0805Y	1	ЧИП-0805; 100 B; X7R; 10 нФ; 10 %; AVX		
		C19, C20	1210Y	C472KAT2A	2	ЧИП-1210; 1 кВ; X7R; 4,7 нФ; 10 %; AVX	
				¥ * ***			
		Микросхемы		\Box			
		DA1	LN	LMV324D		SO-14; Ind; Texas Instruments Incorporated	
		DA2	AP7	1	SOT89; DIODE		
Подп. и дата		DA3	М	1	SOT23-5; Ind; Microchip		
п. п		DD1	PIC	1	SO-18; Ind; Microchip		
Пос		K1	Реле NRP-02-C-12D-H			Питание 12В; мощность 0,2 ВА; Коммутация 30VDC; ЗА	
			Дроссели				
3. Nº 4		L1	SRF0602-470Y		1	Синфазный, 47мкГ, 300мА, Bourns	
NHB.	L2, L3		IMC12	10SY101K	2	ЧИП-1210; 100 мкГн; 73 мА; Vishay	
нв. №		L4, L5 BLM21AG102SN1		2	ЧИП-0805; 1кОм/100МГц; 200 мА; muRata		
Взам. инв.№			Paguaman . P4 40 0 05				
9	-	R1	Резисторы Р1-12-0,25-ххх		ЧИП-1206; 100 ppm; 1 %; Эркон		
na		R2, R3	TO IVICIA		1		
u dar		R6, R7	100 HOW		4		
Побп. и бата		,					
		Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата		003 ПЭ3		
		Разраб.	Аванесов-Ш. Дея 16.11.20	Модуль электронный	Лит.	Лист Листов	
01 2	- 1	Провер. Оформ.	Вацерклянный	мооуль электронный 81402	A	1 3	
ИНВ. № ПООЛ.		Н.контр.	- arriyirodonari	осия 1 16.11.2020 Перечень	OC	О Датчики и	
1	Утверж.		этуновский //// Элементов		системы		

		Поз. обозн				На	пименование	Кол.	Примечание)
				Резис	торы Р1-	12-0,25-	-xxxxx <u>+</u> 1%-M АЛЯР.434110.005 ТУ		ЧИП-1206; 100 ppm; 1 %; Эр	ОКОН
		R4, R1	0				20кОм	3		
		R21								
		R5, R8	8				1 МОм	4		
		R16, R1	19							
		R22					1 кОм	1		
		R25					100 кОм	1		
		R11					47 kOm	1		
		R12					200 kOm	1		
		R13					750 kOm	1		
		R14					330 kOm	1		
		R15					10 kOm	1		
		R17					xxx MOm	1	используется для построй начального тока	ки
		R18 xxx MOm		xxx MOm	1	используется для построй начального тока	ки			
		R20, R2	24				1 kOm	2	na ta breed mena	
		R26					20 Om	1		
ıma		RU1, RU	U2	Bapucmop FNR-10K821		2	AC 510B; 0,4Bm; 110 nΦ			
Подп. и даг										
Подп		SA1		DIP01			1	DIP Switch; 1 pole; TycoElect	tronics	
		SA2			FSM2JH		1	Tactile Switch; 1 pole; 1.6 N; TycoElectronics	4.3 mm;	
6л.									-,	
Инв. № дубл.						Диоды		Diodes		
Инв.										
		VD1V	VD1VD3				BAV99	5	SOT23; Обратное напряже. Ток 150 мА	ние 75 В,
Взам. инв.№		VD7, VD	8							
Взам	<i>VD1, VD8 VD4VD6</i>						BZV55C6V2	3	DO213AA; Обратное напря В; Ток 90 мА.	жение 6,2
		VD9, VD13					SM6T33A	3	DO214AA; Обратное напря В; Ток 90 мА.	жение 33
ma		VD14							, , , , , ,	
и да		VD10					B2S	1	TO-269AA; Обратное напря 200 В; Ток 0,5 А.	яжение
Подп. и дата		VD11				F	YL-3014URC	1	Красный; Iv=3cd; If=20mA; V 3mm; Foryard	′f=2.0V;
		VD12					3014UGC	1	Зеленый; Iv=2,2cd; If=20mA; 3mm; Foryard	Vf=2.2V;
37.									, , v.yu.u	
Инв. № подл.										Лист
Инв.1		Изм. Ли	ıcm	№ докум.	Подп.	Дата	АДЕФ.468323.0	003 ПЭ.	3	2
ت			,,,,	oonym.	. 10011.					1

Поз. обозн.	Наименование		Примечание
	Транзисторы		SOT-23, MOSFET-N,
VT3, VT4	2N7002	3	STMicroelectronics
VT6			
	Соединители		DEGSON
XP1	PLS2-3	1	штыри 3 контакта; шаг 2мм
XP2	PL2-14	1	штыри 14 контактов; 2 ряда; шаг
XS1	PBS2-5	1	2мм гнездо 5 контактов; шаг 2мм
XS2	PBD2-14	1	гназдо 14 контактов; 2 ряда; шаг
XT1	DG103-5,0-4-14HB	1	2мм Клеммная колодка; шаг 5мм; 4
X1, X2	Отверстия для крепления, изготовлены печатным способом	2	клеммы Диаметр 4,5мм
,	The state of the s		
			1,,
	АДЕФ.468323.00	03 ПЭ	<i>Лист</i>
Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата		3

Подп. и дата

Подп. и дата Взам. инв. № | Инв. № дубл.

Инв. № подл.